

Rohm[®]
QUALITY · RELIABILITY



PNP
type

2SA785 2SA786
2SA825 2SA826

トランジスタ

PNP エピタキシャルプレーナ型

シリコントランジスタ

低周波増幅用

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース電圧	2SA785, 2SA825	VCBO	V
	2SA786, 2SA826	VCBO	
コレクタ・エミッタ電圧	2SA785, 2SA825	VCE	V
	2SA786, 2SA826	VCE	
エミッタ・ベース電圧	VEBO	-5	V
コレクタ電流	Ic	-50	mA
コレクタ損失	2SA785, 2SA825	Pc	mW
	2SA825, 2SA826	Pc	
接合部温度	Tj	125	°C
保存温度	Tstg	-55~125	°C

■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)

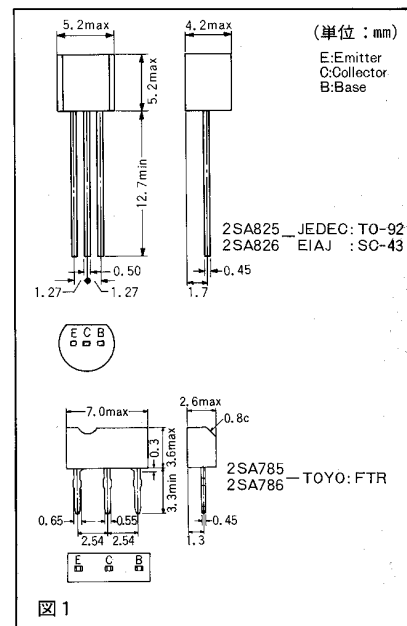
項 目	記 号	MIN	TYP	MAX	単 位	条 件
コレクタ・エミッタ 降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CE}	-80	—	—	V Ic = -1mA, R _{BE} = 10KΩ
	2SA786, 2SA826	BV _{CE}	-40	—	—	
コレクタ・ベース 降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CB}	-80	—	—	V Ic = -50μA
	2SA786, 2SA826	BV _{CB}	-50	—	—	
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EB}	-5	—	—	V	I _E = -50μA
コレクタシャ断電流	2SA785, 2SA825	I _{CB}	—	—	-1	μA V _{CB} = -50V V _{CB} = -30V
	2SA786, 2SA826	I _{CB}	—	—	-1	
エミッタシャ断電流	I _{EB}	—	—	-1	μA	V _{EB} = -4.5V
直流電流増幅率	h _{FE}	82	—	270	—	V _{CE} = -3V, I _C = -10mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE} (sat)	—	—	-0.5	V	I _C = -10mA, I _B = -1mA
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f _T	—	180	—	MHz	V _{CE} = -5V, I _E = 10mA
コレクタ出力容量	C _{ob}	—	6.5	—	pF	V _{CB} = -6V, I _E = 0, f = 1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

注) 2SA786および2SA826のh_{FE}範囲は82~390です。

■ 外形寸法図 (Physical Dimension)



2SA785 2SA786
2SA825 2SA826